

委 員 各 位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 岸野 克巳

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 94 回委員総会・第 98 回研究会 開催案内

日時：平成 28 年 5 月 13 日（金）

委員総会： 12:00 - 12:50

研究会： 13:00 - 17:10

場所： 主婦会館プラザエフ（東京、四ツ谷）

B 2 F クラルテ

〒102-0085 東京都千代田区六番町 15 番地, TEL: 03-3265-8111、URL : <http://www.plaza-f.or.jp/>

委員総会

議 題：

- (1) 前回第 93 回委員総会 議事要録 承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 役員構成の変更について
- (4) 第 100 回研究会・記念シンポジウム(10/28-29)について
- (5) 次回第 99 回研究会以降の研究会について
- (6) 日本結晶成長学会 第 8 回窒化物半導体結晶成長講演会（5/9-10 開催：京都大学）の協賛について（事後承認）
- (7) ISPlasma2017/IC-PLANTS2017（2017 年 3 月開催予定：中部大学）から協賛依頼について
- (8) その他

報告事項：

- (1) 照明学会 LS15(5/22-27：京都大学)の開催案内
- (2) 公開シンポジウム「省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発」開催案内
- (3) 日本結晶成長学会 第 8 回窒化物半導体結晶成長講演会の開催報告
- (4) その他

研究会 主 題：「光・電子デバイス応用に向けた新しい視点からのワイドギャップ半導体の
新規材料・結晶成長・評価」

「委員長挨拶・企画の趣旨説明」 (13 : 00 - 13 : 05)

1. 「立方晶窒化ホウ素(c-BN)薄膜のヘテロエピタキシャル成長」 (13 : 05 - 13 : 50)
平間 一行, 谷保 芳孝, 山本 秀樹, 熊倉 一英 (NTT 物性科学基礎研究所)

2. 「グラフェンと六方晶 BN の単結晶成長へのアプローチ」 (13 : 50 - 14 : 35)
日比野 浩樹 (関西学院大学, NTT 物性科学基礎研究所)

3. 「時間空間分解カソードルミネッセンスによる
ワイドバンドギャップⅢ族窒化物半導体の評価」 (14 : 35 - 15 : 20)
秩父重英, 山崎芳樹, 小島一信 (東北大学)

休憩 (15 : 20 - 15 : 40)

4. 「ダイヤモンドのヘテロエピタキシャル成長技術の開発と高品質化の試み」 (15 : 40 - 16 : 25)

澤邊 厚仁 (青山学院大学)

5. 「ダイヤモンド量子センシング技術」

(16 : 25 - 17 : 10)

波多野 睦子 (東京工業大学)

<追記>

1. 5月13日の委員総会では、ご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 当日は、出席名簿にご署名・交通費の要否・空路陸路の種別等のご記入をお願いいたします。
ご記入の無い場合は、学振からのお支払ができませんので、よろしく願いいたします。
3. 準備の都合上、委員総会・研究会の出欠回答を4月28日(木)までに日本学術振興会研究事業課 須賀 様 (jigyouka06@jsps.go.jp)宛に、必ずご連絡くださいますようお願いいたします。